

창립
40주년 학술대회
논문 87-K-20-7

충량이행형 방전이기 역사이며 레이저의
전압 전류 특성

정재근*, 최우연, 이주희
경희대학교 전자공학과

The Characteristic of Voltage and Current
in Discharge-pumped Excimer Laser with Charge Transfer Type

JAE-KEUN JUNG *, BOO-YEON CHOI, CHOO-HIE LEE
Dept. of Electronic Engineering, Kyung Hee University

ABSTRACT

We calculated the discharge resistance, which is determined by plasma dynamics, of the discharge pumped excimer lasers with charge-transfer type. And investigated the characteristic of discharge voltage and current using EMTP.

I. 서론

충량이행형 방전이기 역사이며 레이저는 최근 반도체 비세가공을 여러 분야에서 연구, 활용되고 있다[1].

효율적인 레이저 발진을 위해서는 효율적인 레이저 장치가 필수적인데 이를 위해서는 레이저 장치의 정확한 해석이 중요하다.

그리므로 본 논문에서는 플라즈마 다이나믹스에 의해 결정되는 비선형 저항인 방전 저항을 구하여, EMTP[2]를 이용하여 충량이행형 방전이기 장치의 방전 진압, 전류 특성을 고찰한다.

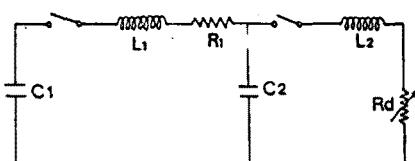


그림 1. 충량이행형 방전이기 장치의 증가외로

II. 방전저항 및 전압, 전류 특성

그림 1은 충량이행형 방전이기 장치의 증가외로를 나타낸다. 각 회로소자의 용량은 실험적, 이론적으로 간단히 구해지지만, 방전관 내부 저항인 R_d 는 비선형 저항으로서 플라즈마 다이나믹스에 의해 계산되며 다음과 같은 수식으로 표현된다[3].

$$R_d = d / (\epsilon A \mu_e n_e) \quad \dots \dots (1)$$

여기에서 d 는 전극의 간격, ϵ 는 전자의 전하(1.6×10^{-19}), A 는 방전 플라즈마의 유효 단면적, μ_e 는 전자의 이동도, n_e 는 전자의 수 밀도이다. 그러므로 방전 저항 R_d 는 전자의 수 밀도 n_e 와 전자의 이동도 μ_e 에 의해 비선형적인 형태를 나타낸다.

방전은 주로 이온화 과정을 거쳐 전자에 의해 직접 여기되는 의가스에 의하여 좌우되며, 할로겐 도우너와 전자의 해리 부착에 의해 관화된다. 그러므로 전자 수 밀도 n_e 는 다음의 식[4]으로 주어진다.

$$dn_e/dt = S + (\alpha - \beta) n_e \quad \dots \dots (2)$$

여기에서 S 는 UV 에비전리에 의해 생성되는 이온-전자쌍의 생성률, α 는 2차전자에 의한 이온화율, β 는 할로겐 도우너에 의한 해리 부착율을 나타낸다.

전자의 이동도 μ_e 는 가스성분과 E/P에

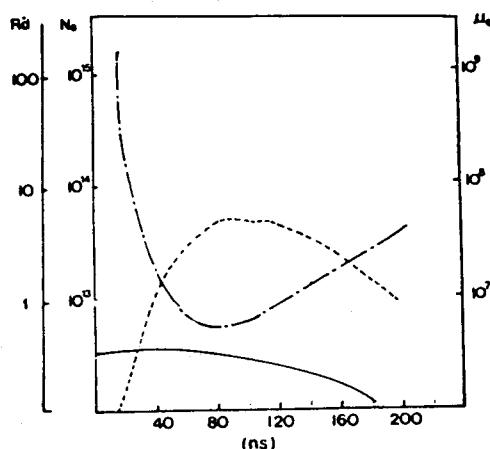


그림 2. μ_0 , n_0 , R_d 의 계산결과

의해 좌우되는데 대부분 He 혹은 Ar를 포함하는 전형적인 레이저 혼합물에 있어서는 E/P 에 악하게 의존한다. 본 실험장치[5]에서 가스 혼합비가 $Kr/F_2/He = 6/0.2/95.8$ 이므로 He 이 95% 이상을 차지한다. 그러므로 μ_0 는 근사적으로 다음의 식[6]으로 표현이 가능하다.

$$\mu_0 (\text{cm/sec}) = 1.21 \times 10^6 (E(t)/P) \quad (3)$$

여기에서 $E(t)$ 는 시간에 따른 전계(V/cm), P 는 가스압력(torr)을 나타낸다.

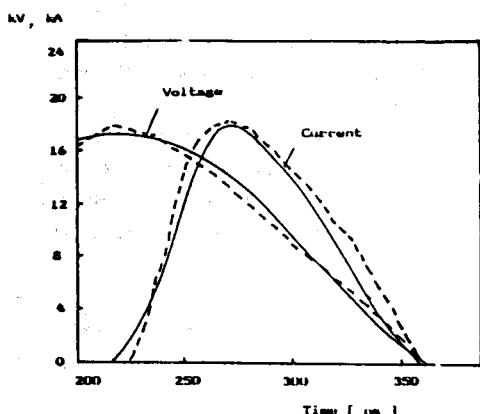


그림 3. 전압 전류 파형

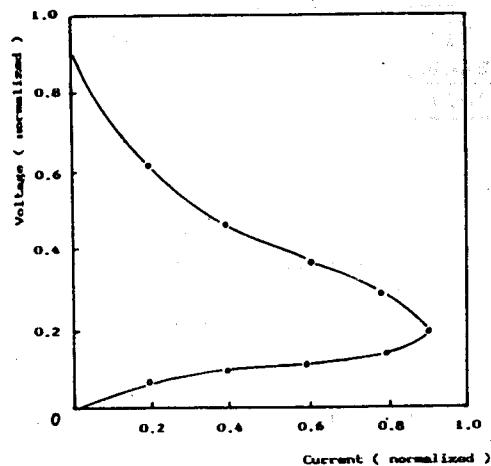


그림 4. 정규화한 전압전류

그림 2는 일의 식 (2), (3)으로 계산한 전자의 수밀도 n_0 와 전자의 이동도 μ_0 , 그리고 이를 식(1)에 대입하여 구한 R_d 를 그래프로 나타낸 것이다. 전자의 이동도 μ_0 는 시간에 대해서 거의 변화가 없으나 전자의 수밀도 n_0 는 시간에 대해 급격히 증가하여 이는 그림 3에서 전류파형과 거의 유사한 모양을 나타내는 것을 알 수 있다.

그림 3은 전압, 전류 파형을 나타낸 것으로 EMTP (Electro-Magnetic Transients Program)로 계산한 것이다. 그림에서 정신은 이론적으로 계산한 값이며 실선은 실험치를 나타내는데 이는 $CuS\bar{O}_4$ 전압분압기와 토고스키 코일로 각각 40000 : 1, 3000 : 1로 측정한 것이다.

그림 4는 정규화한 전압 전류 파형으로 동일 시간에서의 방전 전압, 전류를 표시한 것이다. 전압이 낮은 상태에서 전류가 많이 유통을 얻을 수 있는데 이는 방전전류가 방전전압의 피크에서 으르기 시작하여 방전저항이 최소가 될 때 거의 피크치에 유통을 할 수 있다. 즉 전자수밀도 n_0 에 의해서 방전저항 및 전류가 결정됨을 알 수 있다.

III. 결론

본 논문에서는 방전 플라즈마에 의해 결정되는 비선형 방전 저항을 구하고 EMTP를 이용하여 방전관 내의 방전전압, 전류를 계산하여 실험치와 비교하였다. 그 결과 방전저항은

전자와 이동도와 전자의 수입도에 대해서 비 선형적인 성내를 나타내며 주로 전자수입도에 의한다는 것을 알 수 있었으며 그림 3에서 알 수 있듯이 실험과 계산결과가 잘 일치함을 알 수 있었다. 그러나 장치의 전압, 전류 특성을 고찰할 때 있어서 방전관부의 인덕턴스 값이 40㎹로 크기 때문에 전류의 상승시간이 높아지므로 본 장치로 행한 역사이며 페이저의 발진실험에서 표율이 극히 낮은 이유를 한식할 수 있었다.

참고 문헌

- [1] 이 주희, 전기학회지, vol.33 (6), 10, 1984
- [2] H.W.Dommel, IEEE Trans. Power Apparatus Syst. PAS-88 (4), 388, 1969
- [3] M.Maeda, et al, Japan J. Appl. Phys., 21 (8), 1161, 1982
- [4] R.C.Sue, IEEE J. Quantum Electronics, 15 (15), 1330, 1979
- [5] 정재근, 쇠부인, 이주희, 전기, 전자
학술대회 논문집(I), 45, 1987
- [6] 小池勇二郎, 氣體放電, 84, 1960